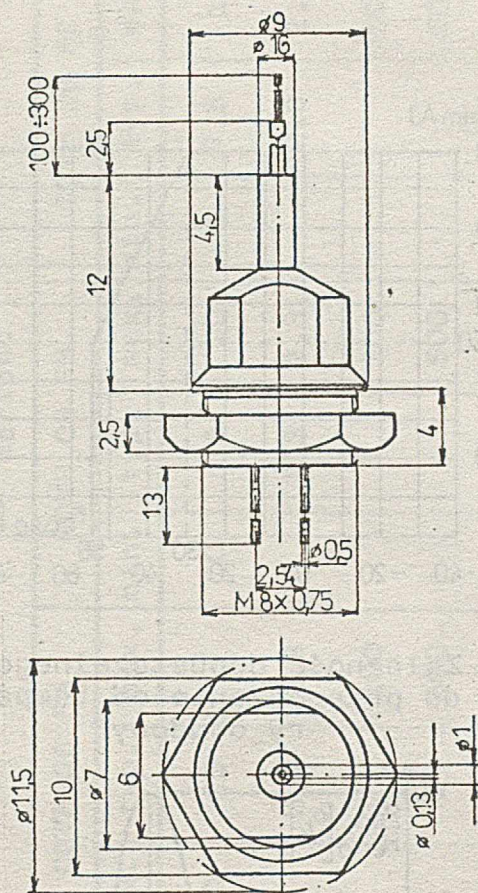
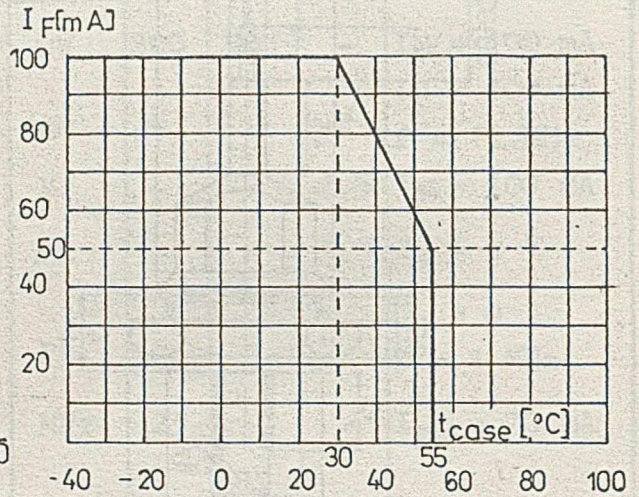
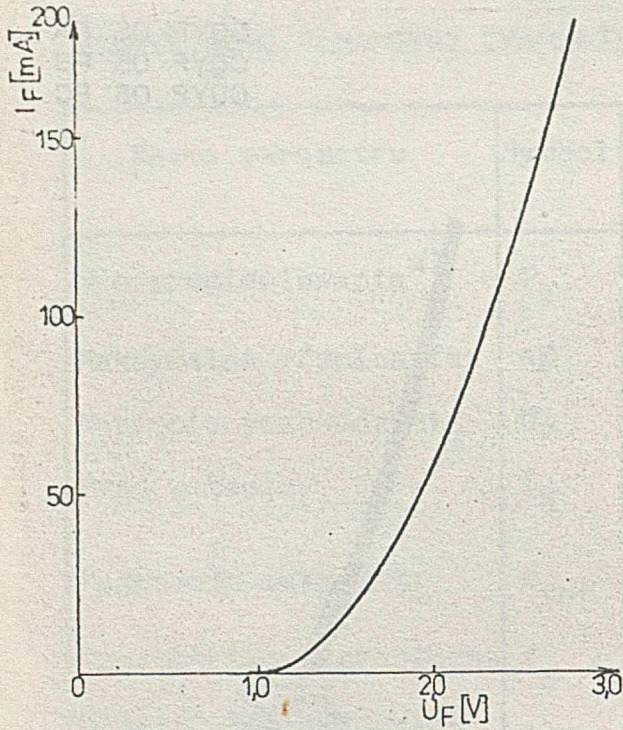


DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA

CQYP 06 FA
 CQYP 06 FB
 CQYP 06 FC

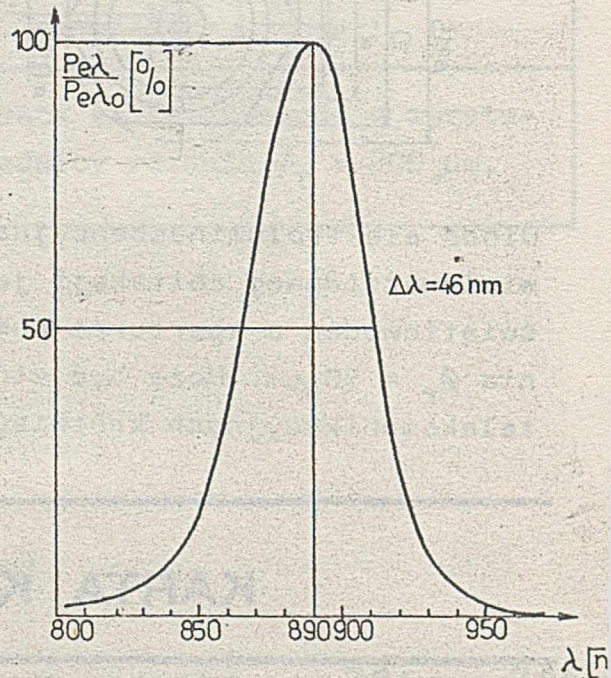
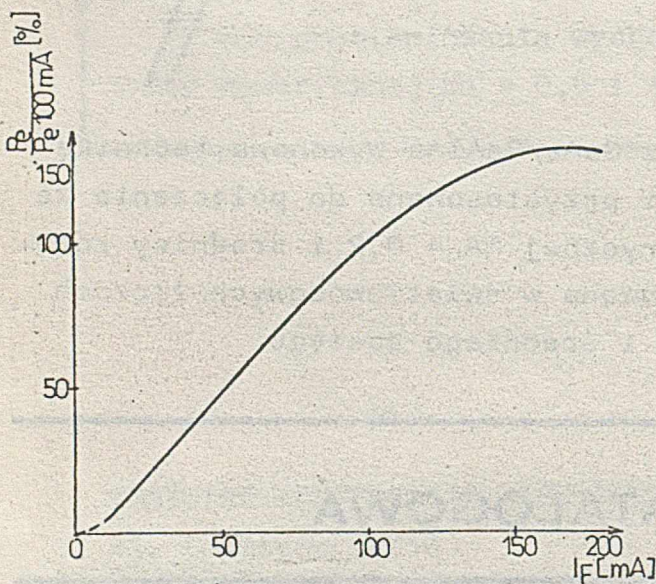


Dioda elektroluminescencyjna z GaAs/GaAlAs wykonana techniką wielowarstwowej epitaksji jest przystosowana do połączenia ze światłowodem o aperturze numerycznej $NA = 0,2$ i średnicy rdzenia $\phi_r = 50 \mu m$. Może być stosowana w światłowodowych łączach telekomunikacyjnych krótkiego i średniego zasięgu.



Charakterystyka prądowo-napięciowa

Zależność dopuszczalnego prądu przewodzenia od temperatury obudowy



Charakterystyka mocowo-prądowa

Względny widmowy rozkład mocy promieniowania

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE / $t_{case} = 25^{\circ}C$

Parametr	Sym- bol	Jedn.	Wartość								Warunki pomiaru
			CQYP 06 FA		CQYP 06 FB		CQYP 06 FC		max.		
			min.	typ.	max.	typ.	min.	typ.		max.	
Moc promienio- wania	P_c	μW	20	25	10	15	20	5	7,5	10	$I_F = 100 \text{ mA}$
Napięcie prze- wodzenia	U_F	V		2,3		2,3	2,8		2,3	2,8	$I_F = 100 \text{ mA}$
Prąd wsteczny	I_R	μA					100			100	$U_R = 2 \text{ V}$
Pojemność cał- kowita	C_{tot}	pF					500			500	$U_R = 0$ $f_p = 1 \text{ MHz}$
Długość fali odpowiadająca maksimum gę- stości mono- chromatycznej mocy promie- niowania	λ_p	nm	840	875	840	875	910	840	875	910	$I_F = 100 \text{ mA}$
Szerokość po- łówkowa widma promieniowa- nia	$\Delta\lambda_{0,5}$	nm		40		40	50		40	50	$I_F = 100 \text{ mA}$
Czas narasta- nia i opada- nia impulsu promieniowa- nia	τ_r / τ_f	ns		12/12		12/12	15/15		12/12	15/15	$I_{FM} = 100 \text{ mA}$
Częstotliwość graniczna	f_g	MHz	23		23					23	$I_{FM} = 70 \text{ mA}$

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE PARAMETRÓW

Prąd przewodzenia	I_F	100	mA
Napięcie wsteczne	U_R	2	V
Temperatura obudowy	t_{case}	-40 \div +55	$^{\circ}C$
Temperatura przechowywania	t_{stg}	-40 \div +70	$^{\circ}C$

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

tel. 435401

tlx 815647

maj 1987

Cena 40 zł

Druk ZOINTE ITE zom. 69/87 n. 300

Parametry i obudowa mogą ulec zmianie

PRAWO REPRODUKOCJI ZASTRZEŻONE